## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-338833

(43) Date of publication of application: 27.11.2002

(51)Int.CI.

C08L101/02 C08K 5/5415 C08K 5/5435 C08L 47/00 G02B 1/04 H01L 33/00

(21)Application number : 2002-044708

(71)Applicant: KANEGAFUCHI CHEM IND CO LTD

NICHIA CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

21.02.2002

(72)Inventor: OUCHI KATSUYA

TSUMURA MANABU SAKAMOTO HARUMI FUJITA MASAYUKI KURAMOTO MASAFUMI

MIKI MICHIHIDE

(30)Priority

Priority number: 2001048549

Priority date: 23.02.2001

Priority country: JP

# (54) COMPOSITION FOR OPTICAL MATERIAL, OPTICAL MATERIAL, ITS MANUFACTURING METHOD, AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND LIGHT-EMITTING DIODE OBTAINED USING THE SAME

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a composition for an optical material hardly undergoing photodeterioration, having a small linear expansion coefficient and exhibiting a high optical transparency, an optical material, its manufacturing method, and a liquid crystal display device and a light-emitting diode each obtained using the same.

SOLUTION: The composition for an optical material comprises as essential ingredients (A) an organic compound bearing in one molecule at least two carbon-carbon double bonds reactive with an SiH group, (B) a silicon compound bearing in one molecule at least two SiH groups, (C) a hydrosilylation catalyst, (D) a compound bearing in one molecule at least two hydrolyzable groups bonded to a metal atom and/or a semi-metal atom, and/or a partial condensate thereof, and (E) water and/or a water-generating compound.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-338833 (P2002-338833A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成14年11月27日(2002.11.27)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 8 L 101/02		C 0 8 L 101/02	4J002
C 0 8 K 5/5415		C08K 5/5415	5 F O 4 1
5/5435		5/5435	
C08L 47/00		C 0 8 L 47/00	
G02B 1/04		G 0 2 B 1/04	
	審查請求	未請求 請求項の数29 OL	(全23頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2002-44708(P2002-44708)	(71)出顧人 000000941	
		鐘淵化学工業物	朱式会社
(22)出願日	平成14年2月21日(2002.2.21)	大阪府大阪市;	比区中之島3丁目2番4号
		(74)上記1名の代理人 100	086586
(31)優先権主張番号	特願2001-48549 (P2001-48549)	弁理士 安江	富康男 (外1名)
(32)優先日	平成13年2月23日(2001.2.23)	(71)出顧人 000226057	
(33)優先権主張国	日本 (JP)	日亜化学工業材	朱式会社
		徳島県阿南市_	上中町岡491番地100
•		(74)上記1名の代理人 100086586	
		弁理士 安1	富 康男
		(72)発明者 大内 克哉	
		大阪府摂津市県	為飼西5丁目5-35-505

(54)【発明の名称】 光学材料用組成物、光学材料、その製造方法、並びにそれを用いた液晶表示装置および発光ダイ

#### (57)【要約】

【課題】 光劣化が少なく、線膨張係数が小さく、さら に光学的透明性が高い、光学材料用組成物、光学材料、 その製造方法、並びにそれを用いた液晶表示装置及び発 光ダイオードを提供することである。

(A)SiH基と反応性を有する炭素-【解決手段】 炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有機 化合物、(B) 1分子中に少なくとも2個のSiH基を 含有するケイ素化合物、(C)ヒドロシリル化触媒、

(D) 金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分 解性基を1分子中に少なくとも2個含有する化合物、及 び/又は、その部分縮合物、並びに(E)水及び/又は 水を生成する化合物を必須成分として光学材料用組成物 とすること。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) Si H基と反応性を有する炭素ー炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有機化合物、(B) 1分子中に少なくとも2個のSi H基を含有するケイ素化合物、(C) ヒドロシリル化触媒、

(D) 金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基を1分子中に少なくとも2個含有する化合物、及び/又は、その部分縮合物、並びに(E)水及び/又は水を生成する化合物を必須成分として含有することを特徴とする光学材料用組成物。

【請求項2】 (A) 成分が、Si H基と反応性を有するビニル基を1分子中に少なくとも1個合有する有機化合物であることを特徴とする請求項1記載の光学材料用組成物。

【請求項3】 (A) 成分が、SiH基と反応性を有するアリル基を1分子中に少なくとも1個含有する有機化合物であることを特徴とする請求項1記載の光学材料用組成物。

【請求項4】 (A) 成分が、1,2ーポリブタジエン、ビニルシクロヘキセン、シクロペンタジエン、ジシクロペンタジエン、ジビニルビフェニル、またはビスフェノールAジアリルエーテルであることを特徴とする請求項1記載の光学材料用組成物。

【請求項5】 (A) 成分が、トリアリルイソシアヌレート、またはトリビニルシクロヘキサンであることを特徴とする請求項1記載の光学材料用組成物。

【請求項6】 さらに(F)縮合触媒を必須成分として 含有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれかー 項に記載の光学材料用組成物。

【請求項7】 (F)縮合触媒がTi系縮合触媒であることを特徴とする請求項6記載の光学材料用組成物。

【請求項8】 (D) 成分の金属原子が、AI、Zn、Ga、Ge、Sn、Mg、Ca、Ti、及びZrからなる群より選ばれる一種あるいは複数の原子であり、半金属原子がB及び/又はSiであることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載の光学材料用組成物。

【請求項9】 (D) 成分の加水分解性基が、アルコキシ基、シロキシ基、アシロキシ基、及びハロゲン基からなる群より選ばれる一種あるいは複数の基であることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の光学材料用組成物。

【請求項10】 光学材料が液晶用フィルムである請求 項1乃至9のいずれか一項に記載の光学材料用組成物。

【請求項11】 光学材料が液晶用プラスチックセルである請求項1乃至9のいずれか一項に記載の光学材料用組成物。

【請求項12】 光学材料が発光ダイオードの封止材である請求項1乃至9のいずれか一項に記載の光学材料用組成物。

【請求項13】 請求項1乃至12のいずれか一項に記

載の光学材料用組成物をあらかじめ混合し、組成物中の SiH基と反応性を有する炭素ー炭素二重結合とSiH 基の一部または全部を反応させ、金属原子及び/又は半 金属原子に結合した加水分解性基を加水分解縮合反応さ せることによって硬化させてなる光学材料。

【請求項14】 請求項1乃至12にいずれか一項に記載の光学材料用組成物をあらかじめ混合し、組成物中のSiH基と反応性を有する炭素一炭素二重結合とSiH基の一部または全部を反応させ、金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基を加水分解縮合反応させることによる、請求項13に記載の光学材料を製造する方法。

【請求項15】 請求項13に記載の光学材料を用いた 液晶表示装置。

【請求項16】 請求項13に記載の光学材料を用いた 発光ダイオード。

【請求項17】 (A) Si H基と反応性を有する炭素 一炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有 機化合物、(B) 1分子中に少なくとも2個のSi H基 を含有するケイ素化合物、(C) ヒドロシリル化触媒、

(D) 金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基を1分子中に少なくとも2個含有する化合物、及び/又は、その部分縮合物、並びに(E)水及び/又は水を生成する化合物を必須成分として含有する硬化性組成物を用いて発光索子が被覆された発光ダイオード。

【請求項18】 (A)成分は、SiH基と反応性を有するビニル基を1分子中に少なくとも1個含有する有機化合物であることを特徴とする請求項17記載の発光ダイオード。

【請求項19】 (A)成分は、SiH基と反応性を有するアリル基を1分子中に少なくとも1個含有する有機化合物であることを特徴と請求項17記載の発光ダイオード。

【請求項20】 (A) 成分は、1,2ーポリブタジェン、ビニルシクロヘキセン、シクロペンタジエン、ジシクロペンタジエン、ジビニルビフェニル、またはビスフェノールAジアリルエーテルであることを特徴とする請求項17記載の発光ダイオード。

【請求項21】 (A) 成分は、トリアリルイソシアヌレート、またはトリピニルシクロヘキサンであることを特徴とする請求項17記載の発光ダイオード。

【請求項22】 前記硬化性組成物は、さらに(F) 縮合触媒を必須成分として含有することを特徴とする請求項17乃至21のいずれか一項に記載の発光ダイオード。

【請求項23】 (F)縮合触媒は、Ti系縮合触媒であることを特徴とする請求項22に記載の発光ダイオード。

【請求項24】 (D)成分の金属原子は、AI、Z n、Ga、Ge、Sn、Mg、Ca、Ti、及びZrか らなる群より選ばれる一種あるいは複数の原子であり、 半金属原子は、B及び/又はSiであることを特徴とす る請求項17乃至23のいずれか一項に記載の発光ダイ オード。

【請求項25】 (D) 成分の加水分解基は、アルコキシ基、シロキシ基、アシロキシ基、及びハロゲン基からなる群より選ばれる一種あるいは複数の基であることを特徴とする請求項17乃至24のいずれかに記載の発光ダイオード。

【請求項26】 前記硬化性組成物は、前記発光素子を被覆する前にあらかじめ混合されて組成物中のSiH基と反応性を有する炭素一炭素二重結合とSiH基の一部または全部が反応し金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基が加水分解縮合反応していることを特徴とする請求項17乃至25のいずれか一項に記載の発光ダイオード。

【請求項27】 前記発光索子は、珪素を含有する無機 化合物層を表面に有し、前記無機化合物層に接して、前 記硬化性組成物から得られる透光性封止材が設けられて いることを特徴とする請求項17乃至26のいずれか一 項に記載の発光ダイオード。

【請求項28】 前記無機化合物層は、前記発光素子から発光される光の少なくとも一部を吸収して他の波長を有する光を発光することが可能な蛍光物質を有することを特徴とする請求項27記載の発光ダイオード。

【請求項29】 (A) Si H基と反応性を有する炭素 一炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有 機化合物、(B) 1分子中に少なくとも2個のSi H基 を含有するケイ素化合物、(C) ヒドロシリル化触媒、

(D) 金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基を1分子中に少なくとも2個含有する化合物、及び/又は、その部分縮合物、並びに(E)水及び/又は水を生成する化合物を必須成分として含有する硬化性組成物を用いて発光素子が被覆された発光ダイオードの製造方法であって、前記硬化性組成物は、前記発光素子を被覆する前にあらかじめ混合されて組成物中のSiH基と反応性を有する炭素一炭素二重結合とSiH基の一部または全部が反応し金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基が加水分解縮合反応していることを特徴とする発光ダイオードの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光学材料に関するものであり、更に詳しくは線膨張係数が小さく、さらに光学的透明性が高い光学材料用組成物、光学材料、その製造方法、およびそれを用いた液晶表示装置および発光ダイオードに関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】液晶表示装置用をはじめとする光学材料 としては、複屈折率が低く、光弾性係数が小さく、光学 的透明性の高い材料が使用される。また、液晶表示装置 用等の材料の場合には、製造プロセス上使用する材料に は高い耐熱性が必要である。こういった要求を満足する 材料として従来ガラス等が使用されてきた。

【0003】液晶表示装置用をはじめとする光学材料は薄いフィルム状あるいは細いチューブやロッド状で多く使用されるが、近年の市場要求に従い、より薄いフィルム状、あるいはより細いチューブまたはロッド状での使用が必要になってきている。しかし、従来使用されてきたガラスは強度的に脆い性質を有しているため、使用範囲に限界が生じてきている。

【0004】強靭性のある材料としては高分子材料があるが、例えば熱可塑性樹脂の場合は、一般に高い耐熱性を発現させるために芳香族骨格を導入すると、複屈折率が高くなり光弾性係数が大きくなるため、高い耐熱性と光学的性能の両立が困難である。

【0005】熟硬化性樹脂の場合は、従来知られている 熱硬化性樹脂は一般に着色しており、光学材料用途には 向かない。さらに、一般に極性を有しており光学的性能 発現にも不利である。そこで、例えば発光ダイオードの 封止材用途では、特殊な熱硬化性樹脂として、酸無水物 系硬化剤を用いる透明エポキシ樹脂が広く用いられて樹 た。しかし、かかる透明エポキシ樹脂においても、、 が低い、あるいは光学が低いために耐光耐 に低波長の光に対する光線透過性が低いために耐光点 性が低い、あるいは光劣化により着色するという欠き 有していた。一方、耐光耐久性が高い被覆材としてあり はが低い、あるいは光光が高い被覆材としてあり 性が低い、表表いは光光でしてが高い 力コーン樹脂が使用されているが、一般に軟質であり リコーン樹脂が使用されているが、一般に軟質であり りっク性を有しているため、実装する際に発光面に 物が付着したり実装用器具により発光面が損傷を受ける という問題があった。

【0006】また、高分子材料は一般に線膨張係数が大きく加熱成形時の寸法安定性が低くなりやすいため、種々のフィラーを添加する場合があるが、この場合、一般的な粒子状フィラーを添加すると光学的な透明性が損なわれるという問題があった。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、光劣化が少なく、線膨張係数が小さく、さらに光学的透明性が高く、実装する際に発光面に異物が付着したり実装用器具により発光面が損傷を受けるという問題が生じない、光学材料用組成物、光学材料、その製造方法、およびそれを用いた液晶表示装置および発光ダイオードを提供することである。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するために本発明者らは鋭意研究の結果、SiH基と反応性を有する炭素一炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有機化合物と、1分子中に少なくとも2個のSiH基を含有するケイ素化合物と、ヒドロシリル化触媒

と、金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解 性基を1分子中に少なくとも2個含有する化合物と、水 及び/又は水を生成する化合物を必須成分として光学材 料用組成物とすることにより、上記課題を解決できることを見出し、本発明に至った。

【0009】すなわち、本発明は、(A) Si H基と反 応性を有する炭素-炭素二重結合を1分子中に少なくと も2個含有する有機化合物、(B) 1分子中に少なくと も2個のSiH基を含有するケイ素化合物、(C)ヒド ロシリル化触媒、(D)金属原子及び/又は半金属原子 に結合した加水分解性基を1分子中に少なくとも2個含 有する化合物、及び/又は、その部分縮合物、並びに (E) 水及び/又は水を生成する化合物を必須成分とし て含有することを特徴とする光学材料用組成物(請求項 1)であり、(A)成分が、SiH基と反応性を有する ビニル基を1分子中に少なくとも1個含有する有機化合 物であることを特徴とする請求項1記載の光学材料用組 成物(請求項2)であり、(A)成分が、SiH基と反 応性を有するアリル基を1分子中に少なくとも1個含有 する有機化合物であることを特徴とする請求項1記載の 光学材料用組成物(請求項3)であり、(A)成分が、 1, 2-ポリブタジエン、ビニルシクロヘキセン、シク ロペンタジエン、ジシクロペンタジエン、ジビニルビフ ェニル、またはビスフェノールAジアリルエーテルであ ることを特徴とする請求項1記載の光学材料用組成物 (請求項4)であり、(A)成分が、トリアリルイソシ

とを特徴とする請求項1記載の光学材料用組成物(請求項5)であり、さらに(F)縮合触媒を必須成分として合有することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の光学材料用組成物(請求項6)であり、(F)縮合触媒がTi系縮合触媒であることを特徴とする請求項6記載の光学材料用組成物(請求項7)であり、(D)成分の金属原子が、AI、Zn、Ga、Ge、Sn、Mg、Ca、Ti、及びZrからなる群より選ばれる一種あるいは複数の原子であり、半金属原子がB及び/又はSiであることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか一項に記載の光学材料用組成物(請求項8)であり、「BD、成分の加水分解性其が、アルコキシ

アヌレート、またはトリビニルシクロヘキサンであるこ

8)であり、(D)成分の加水分解性基が、アルコキシ基、シロキシ基、アシロキシ基、及びハロゲン基からなる群より選ばれる一種あるいは複数の基であることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の光学材料用組成物(請求項1乃至9のいずれか一項に記載の光学材料用組成物(請求項10)であり、光学材料が液晶用プラスチックセルである請求項1乃至9のいずれか一項に記載の光学材料用組成物(請求項11)であり、光学材料が発光ダイオードの封止材である請求項1乃至9のいずれか一項に記載の光学材料用組成物(請求項12)であり、請求項1乃至12のいずれか一項に記載の光学

材料用組成物をあらかじめ混合し、組成物中のSiH基と反応性を有する炭素一炭素二重結合とSiH基の一部または全部を反応させ、金属原子及び/又は半金属原子及びに結合した加水分解性基を加水分解縮合反応させるの光学材料(請求項1乃至12にいずれか一項に記載の光学材料のよいでは全部を反応させるとのでは、組成物をあらかじめ混合し、組成物中のSiH基の一のSiH基の一次素二重結合とSiH基の一部子とは全部を反応させ、金属原子及び/又は半金属原子及び/又は半金属原子及びが表表には全部を反応させるによる、請求項13に記載の光学材料を製造する方法(請求項14)であり、請求項13に記載の光学材料を用いた発光ダイオード(請求項16)である。

【 O O 1 O 】また、本発明の発光ダイオードは、 (A) S i H基と反応性を有する炭素一炭素二重結合を 1 分子中に少なくとも 2 個含有する有機化合物、 (B) 1 分子中に少なくとも 2 個のS i H基を含有するケイ素化合物、 (C) ヒドロシリル化触媒、 (D) 金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基を 1 分子中に少なくとも 2 個含有する化合物、及び/又は、その部分縮合物、並びに (E) 水及び/又は水を生成する化合物を必須成分として含有する硬化性組成物を用いて発光索子が被覆された発光ダイオード (請求項 1 7) であり、

(A) 成分は、SiH基と反応性を有するビニル基を1 分子中に少なくとも 1 個含有する有機化合物であること を特徴とする請求項17記載の発光ダイオード (請求項 18)であり、(A)成分は、SiH基と反応性を有す るアリル基を1分子中に少なくとも1個含有する有機化 合物であることを特徴と請求項17記載の発光ダイオー ド(請求項19)であり、(A)成分は、1,2-ポリ ブタジエン、ビニルシクロヘキセン、シクロペンタジエ ン、ジシクロペンタジエン、ジビニルビフェニル、また はビスフェノールAジアリルエーテルであることを特徴 とする請求項17記載の発光ダイオード (請求項20) であり、(A)成分は、トリアリルイソシアヌレート、 またはトリビニルシクロヘキサンであることを特徴とす る請求項17記載の発光ダイオード(請求項21)であ り、前記硬化性組成物が、さらに(F)縮合触媒を必須 成分として含有することを特徴とする請求項17乃至2 1のいずれか一項に記載の発光ダイオード (請求項2 2) であり、(F) 縮合触媒は、Ti系縮合触媒である ことを特徴とする請求項22に記載の発光ダイオード (請求項23)であり、(D)成分の金属原子は、A I、Zn、Ga、Ge、Sn、Mg、Ca、Ti、及び Zrからなる群より選ばれる一種あるいは複数の原子で あり、半金属原子は、B及び/又はSiであることを特 徴とする請求項17乃至23のいずれか一項に記載の発 光ダイオード(請求項24)であり、(D)成分の加水

分解基は、アルコキシ基、シロキシ基、アシロキシ基、 及びハロゲン基からなる群より選ばれる一種あるいは複 数の基であることを特徴とする請求項17乃至24のい ずれかに記載の発光ダイオード(請求項25)である。 【〇〇11】また、本発明の発光ダイオードは、前記硬 化性組成物が、前記発光素子を被覆する前にあらかじめ 混合されて組成物中のSiH基と反応性を有する炭素ー 炭素二重結合とSiH基の一部または全部が反応し金属 原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基が加 水分解縮合反応していることを特徴とする請求項17乃 至25のいずれか一項に記載の発光ダイオード(請求項 26)であり、前記発光素子は、珪素を含有する無機化 合物層を表面に有し、前記無機化合物層に接して、前記 硬化性組成物から得られる透光性封止材が設けられてい ることを特徴とする請求項17乃至26のいずれか一項 に記載の発光ダイオード(請求項27)であり、前記無 機化合物層は、前記発光素子から発光される光の少なく とも一部を吸収して他の波長を有する光を発光すること が可能な蛍光物質を有することを特徴とする請求項27 記載の発光ダイオード (請求項28) である。また、請 求項29に記載の発光ダイオードの製造方法は、(A) SiH基と反応性を有する炭素-炭素二重結合を1分子 中に少なくとも2個含有する有機化合物、(B) 1分子 中に少なくとも2個のSiH基を含有するケイ素化合 物、(C)ヒドロシリル化触媒、(D)金属原子及び/ 又は半金属原子に結合した加水分解性基を 1 分子中に少 なくとも2個含有する化合物、及び/又は、その部分縮 合物、並びに(E)水及び/又は水を生成する化合物を 必須成分として含有する硬化性組成物を用いて発光素子 が被覆された発光ダイオードの製造方法であって、前記 硬化性組成物は、前記発光素子を被覆する前にあらかじ め混合されて組成物中のSiH基と反応性を有する炭素 一炭素二重結合とSiH基の一部または全部が反応し金 属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基が 加水分解縮合反応していることを特徴とする。

#### [0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 【OO13】まず、本発明における(A)成分について 説明する。(A)成分はSiH基と反応性を有する炭素 一炭素二重結合を1分子中に少なくとも2個含有する有 機化合物であれば特に限定されない。有機化合物として はポリシロキサンー有機ブロックコポリマーやポリシロ キサンー有機グラフトコポリマーのようなシロキサン単 位(SiーOーSi)を含むものではなく、構成元素と してC、H、N、O、S、ハロゲンのみを含むものであ ることが好ましい。シロキサン単位を含むものの場合 は、ガス透過性やはじきの問題がある。

【0014】SiH基と反応性を有する炭素ー炭素二重 結合の結合位置は特に限定されず、分子内のどこに存在 してもよい。 【0015】(A)成分の有機化合物は、有機重合体系の化合物と有機単量体系化合物に分類できる。

【0016】有機重合体系化合物としては例えば、ポリエーテル系、ポリエステル系、ポリアリレート系、ポリカーボネート系、飽和炭化水素系、不飽和炭化水素系、ポリアクリル酸エステル系、ポリアミド系、フェノールーホルムアルデヒド系(フェノール樹脂系)、ポリイミド系の化合物を用いることができる。

【0017】また有機単量体系化合物としては例えば、フェノール系、ビスフェノール系、ベンゼン、ナフタレン等の芳香族炭化水素系:直鎖系、脂環系等の脂肪族炭化水素系:複素環系の化合物およびこれらの混合物等が挙げられる。

【0018】(A)成分のSiH基と反応性を有する炭素一炭素二重結合としては特に限定されないが、下記一般式(I)

[0019]

【化1】

【0020】(式中R<sup>1</sup>は水素原子あるいはメチル基を 表す。)で示される基が反応性の点から好適である。ま た、原料の入手の容易さからは、

[0021]

【化2】

【0022】で示される基が特に好ましい。

【0023】(A)成分のSiH基と反応性を有する炭素ー炭素二重結合としては、下記一般式(II)

[0024]

【化3】

【0025】(式中R<sup>1</sup>は水素原子あるいはメチル基を 表す。)で示される脂環式の基が、硬化物の耐熱性が高 いという点から好適である。また、原料の入手の容易さ からは、

[0026]

【化4】

【0027】で示される脂環式の基が特に好ましい。 【0028】SiH基と反応性を有する炭素一炭素二重 結合は(A)成分の骨格部分に直接結合していてもよ く、2価以上の置換基を介して共有結合していても良 い。2価以上の置換基としては炭素数0~10の置換基

であれば特に限定されないが、構成元素としてC、H、N、O、S、ハロゲンのみを含むものが好ましい。これらの置換基の例としては、

[0029] [化5]

$$-0$$

(nは1~10の数を表す。),

(nは0~4の数を表す。) ·

[0030] 【化6】

(nは0~4の数を表す。)

【0031】が挙げられる。また、これらの2価以上の 置換基の2つ以上が共有結合によりつながって1つの2 価以上の置換基を構成していてもよい。 【0032】以上のような骨格部分に共有結合する基の例としては、ビニル基、アリル基、メタリル基、アクリル基、メタクリル基、2ーヒドロキシー3ー(アリルオキシ)プロピル基、2ーアリルフェニル基、3ーアリルフェニル基、4ーアリルフェニル基、2ー(アリルオキシ)フェニル基、4ー(アリルオキシ)フェニル基、2ー(アリルオキシ)エチル基、2、2ービス(アリルオキシメチル)ブチル基、3ーアリルオキシー2、2ービス(アリルオキシメチル)プロピル基、

[0033]

【化7】

 $CH_2$ =CH- $CH_2$ + $\left(0$ - $CH_2$ · $CH_2\right)$ -n( n は 5  $\geq$  n  $\geq$  2 を満足する数を表す。),

$$\begin{array}{c|c} H & H \\ C & CH \\ CH_2 & CH_2 \\ C & CH \\ CH & CH_2 \\ H & CH_2 \\ C & CH \\ C & CH_2 \\ C & CH_$$

(nは0~4の数を表す。)

【0034】が挙げられる。

【0035】(A)成分の具体的な例としては、ジアリルフタレート、トリアリルトリメリテート、ジエチレングリコールビスアリルカーボネート、トリメチロールプロパンジアリルエーテル、ペンタエリスリトールトリアリルエーテル、1, 1, 2, 2ーテトラアリロキシエタン、ジアリリデンペンタエリスリット、トリアリルシアヌレート、トリアリルイソシアヌレート、1, 2, 4ートリビニルシクロヘキサン、ジビニルベンゼン類(純度

50~100%のもの、好ましくは純度80~100%のもの)、ジビニルビフェニル、1、3ージイソプロペニルベンゼン、1、4ージイソプロペニルベンゼン、およびそれらのオリゴマー、1、2ーポリブタジエン(1、2比率10~100%のもの、好ましくは1、2比率50~100%のもの)、ノボラックフェノールのアリルエーテル、アリル化ポリフェニレンオキサイド、【0036】【化8】

$$O$$
  $\longrightarrow$   $R$   $\longrightarrow$   $O$   $\longrightarrow$   $O$ 

[0037]

【化9】

【0038】の他、従来公知のエポキシ樹脂のグリシジル基をアリル基に置き換えたもの等が挙げられる。

【0039】(A)成分としては、上記のように骨格部分と炭素ー炭素二重結合とに分けて表現しがたい、低分子量化合物も用いることができる。これらの低分子量化合物の具体例としては、ブタジエン、イソプレン、オクタジエン、デカジエン等の脂肪族鎮状ポリエン化合物系、シクロペンタジエン、シクロペンタジエン、トリシクロペンタジエン、ノルボルナジエン等の脂肪族環状ポリエン化合物系、ビニルシクロペンテン、ビニルシクロヘキセン等の置換脂肪族環状オレフィン化合物系等が挙げられる。

【0040】上記した(A)成分としては、耐熱性をより向上し得るという観点から、SiH基と反応性を有する炭素一炭素二重結合を(A)成分1gあたり0.001mol以上含有するものであればよいが、さらに、1gあたり0.005mol以上含有するものが好まし

く、O. OO8mol以上含有するものが特に好ましい。

【 O O 4 1 】 (A) 成分のS i H基と反応性を有する炭素一炭素二重結合の数は、平均して1分子当たり少なくとも2個あればよいが、力学強度をより向上したい場合には2を越えることが好ましく、3個以上であることがより好ましい。(A) 成分のS i H基と反応性を有する炭素一炭素二重結合の数が1分子当たり1個以下の場合は、(B) 成分と反応してもグラフト構造となるのみで架橋構造とならない。

【0042】(A)成分としては、他の成分との均一な混合、および良好な作業性を得るためには100℃以下の温度において流動性があるものが好ましく、線状でも枝分かれ状でもよく、分子量は特に制約はないが、50~100,000の任意のものが好適に使用できる。分子量が100,000以上では一般に原料が高粘度となり作業性に劣るとともに、炭素一炭素二重結合とSiH基との反応による架橋の効果が発現し難い。

【0043】また、(A) 成分としては、着色特に黄変の抑制の観点からフェノール性水酸基および/あるいはフェノール性水酸基の誘導体を有する化合物の含有量が少ないものが好ましく、フェノール性水酸基および/あるいはフェノール性水酸基の誘導体を有する化合物を含まないものがより好ましい。本発明におけるフェノール性水酸基とはベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環等に例示される芳香族炭化水素核に直接結合した水酸基を示し、フェノール性水酸基の誘導体とは上述のフェノール性水酸基の水素原子をメチル基、エチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基等のアルケニル基、アセトキシ基等のアシル基等により置換された基を示す。

【0044】また複屈折率が低い、光弾性係数が低い等のように光学特性が良好であるとともに耐候性が良好であるという観点からは、芳香環の(A)成分中の成分重量比が50重量%以下であるものが好ましく、40重量%以下のものがより好ましく、30重量%以下のものがさらに好ましい。最も好ましいのは芳香族炭化水素環を含まないものである。

【 O O 4 5 】得られる硬化物の着色性および光学特性から、 (A) 成分としてはビニルシクロヘキセン、ジシクロペンタジエン、トリアリルイソシアヌレート、2, 2ービス (4ーヒドロキシシクロヘキシル) プロパンのジアリルエーテル、1, 2, 4ートリビニルシクロヘキサンが好ましく、トリアリルイソシアヌレート、2, 2ービス (4ーヒドロキシシクロヘキシル) プロパンのジアリルエーテル、1, 2, 4ートリビニルシクロヘキサンが特に好ましい。

【 0 0 4 6 】次に、 (B) 成分であるS i H基を有する 化合物について説明する。

【0047】本発明に使用できるSiH基を有する化合物については特に制限がなく、例えば国際公開WO96 /15194に記載される化合物で、1分子中に少なく とも2個のSiH基を有するもの等が使用できる。

【0048】これらのうち、入手性の面からは、1分子中に少なくとも2個のSiH基を有する鎖状、及び/又は、環状ポリオルガノシロキサンが好ましく、(A)成分との相溶性が良いという観点から、さらに、下記一般式(III)

[0049]

【化10】

$$\begin{pmatrix}
R^2 \\
S_{i} \\
H
\end{pmatrix}_{n}$$
(III)

【0050】(式中、R<sup>2</sup>は炭素数1~6の有機基を表し、nは3~10の数を表す。)で表される、1分子中に少なくとも2個のSiH基を有する環状ポリオルガノシロキサンが好ましい。なお、一般式(III)で表さ

れる化合物中の置換基R<sup>2</sup>は、C、H、Oから構成されるものであることが好ましく、炭化水素基であることがより好ましい。

【0051】また、前記(A)成分と良好な相溶性を有するという観点からは、鎖状、及び/又は、環状ポリオルガノシロキサンと、炭素一炭素二重結合を有する有機化合物から選ばれた1種以上の化合物(以降(G)成分と称する)との反応物も好ましい。この場合、反応物の(A)成分との相溶性をさらに高めるために、反応物から未反応のシロキサン類等を脱揮等により除去したものを用いることもできる。

【0052】(G)成分はSiH基と反応性を有する炭素一炭素二重結合を1分子中に少なくとも1個含有する有機化合物であって、前記(A)成分と同じ説明のものも使用できる。(G)成分の有機化合物は、(A)成分の有機化合物と同じであってもよく、異なっていてもよい。また単独もしくは2種以上のものを混合して用いることが可能である。(B)成分の(A)成分に対する相溶性を高くしたい場合には、(G)成分は(A)成分と同一のものが好ましい。

【0053】(G)成分の有機化合物と反応させる鎖状、及び/又は、環状ポリオルガノシロキサンとしては、工業的入手性および反応させる場合の反応性が良好であるという観点からは、1,3,5,7ーテトラメチルシクロテトラシロキサンが好ましい。

【0054】(B)成分としても(A)成分と同様に、 着色特に黄変の抑制の観点からフェノール性水酸基および/あるいはフェノール性水酸基の誘導体を有する化合物の含有量が少ないものが好ましく、フェノール性水酸基および/あるいはフェノール性水酸基の誘導体を有する化合物を含まないものがより好ましい。本発明におけるフェノール性水酸基とはベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環等に例示される芳香族炭化水素核に直接結合した水酸基を示し、フェノール性水酸基の誘導体とは上述のフェノール性水酸基の水素原子をメチル基、エチル基等のアルキル基、ビニル基、アリル基等のアルケニル基、アセトキシ基等のアシル基等により置換された基を示す。

【0055】また複屈折率が低い、光弾性係数が低い等のように光学特性が良好であるとともに耐候性が良好であるという観点からは、芳香環の(B)成分中の成分重量比が50重量%以下であるものが好ましく、40重量%以下のものがより好ましく、30重量%以下のものがさらに好ましい。最も好ましいのは芳香族炭化水素環を含まないものである。

【0056】光学特性が良好であるという観点からより好ましい(B)成分としては、1,3,5,7ーテトラメチルシクロテトラシロキサンとビニルシクロヘキセンの反応物、1,3,5,7ーテトラメチルシクロテトラシロキサンとジシクロペンタジエンの反応物、1,3,

5. 7ーテトラメチルシクロテトラシロキサンとトリアリルイソシアヌレートの反応物、1,3,5,7ーテトラメチルシクロテトラシロキサンと2,2ービス(4ーヒドロキシシクロへキシル)プロパンのジアリルエーテルの反応物、1,3,5,7ーテトラメチルシクロへキサンとしい(B)成分としては、1,3,5,7ーテトラメチルシクロテトラシロキサンととリアリルイソシアヌレートの反応物、1,3,5,7ーテトラメチルシクロテトラシロキサンと2,2ービス(4ーヒドロキシシクロへキシル)プロパンのジアリルエーテルの反応物、1,3,5,7ーテトラメチルシクロテトラシロキサンの反応物等が挙げられる。

【OO57】上記したような(A)成分と(B)成分の混合比率は、必要な強度を失わない限りは特に限定されないが、(B)成分中のSiH基の数(Y)の(A)成分中の炭素一炭素二重結合の数(X)に対する比が、2. $O \ge Y / X \ge 0$ .9であることが好ましく、1.8 $\ge Y / X \ge 1$ .Oがより好ましい。2.O < Y / Xの場合は、十分な硬化性が得られず、充分な強度が得られない場合があり、Y / X < 0.9の場合は炭素一炭素二重結合が過剰となり着色の原因となり得る。

【OO58】次に(C)成分であるヒドロシリル化触媒について説明する。

【0059】ヒドロシリル化触媒としては、ヒドロシリ ル化反応の触媒活性があれば特に限定されないが、例え ば、白金の単体、アルミナ、シリカ、カーボンブラック 等の担体に固体白金を担持させたもの、塩化白金酸、塩 化白金酸とアルコール、アルデヒド、ケトン等との錯 体、白金-オレフィン錯体(例えば、Pt(CH2=C  $H_2$ ) 2 (PPh3) 2, Pt (CH2=CH2) 2C lo)、白金ービニルシロキサン錯体(例えば、Pt (ViMe2SiOSiMe2Vi) n, Pt [ (Me ViSiO) 4] m)、白金ーホスフィン錯体(例え ば、Pt (PPh3) 4、Pt (PBu3) 4)、白金 ーホスファイト錯体(例えば、Pt [P(OPh)3] 4、Pt [P(OBu) 3] 4) (式中、Meはメチル 基、Buはブチル基、Viはピニル基、Phはフェニル 基を表し、n、mは、整数を示す。)、ジカルボニルジ クロロ白金、カールシュテト(Karstedt)触 媒、また、アシュピー(Ashby)の米国特許第31 59601号および3159662号明細書中に記載さ れた白金一炭化水素複合体、ならびにラモロー(Lam oreaux)の米国特許第3220972号明細書中 に記載された白金アルコラート触媒が挙げられる。さら に、モディック (Modic) の米国特許第35169 46号明細書中に記載された塩化白金ーオレフィン複合 体も本発明において有用である。

【0060】また、白金化合物以外の触媒の例として

は、RhCl (PPh) 3、RhCl3、RhAl203、RuCl3、IrCl3、FeCl3、AlCl3、PdCl2・2H2O、NiCl2、TiCl4、等が挙げられる。

【0061】これらの中では、触媒活性の点から塩化白金酸、白金ーオレフィン錯体、白金ービニルシロキサン 錯体等が好ましい。また、これらの触媒は単独で使用してもよく、2種以上併用してもよい。

【0062】触媒の添加量は特に限定されないが、十分な硬化性を有し、かつ組成物のコストを比較的低く抑えるために、SiH基1モルに対して、 $10-8\sim10$ -1モルの範囲が好ましく、より好ましくは、 $10-6\sim10-2$ モルの範囲である。

【 O O 6 3 】また、上記触媒には助触媒を併用することが可能であり、例としてトリフェニルホスフィン等のリン系化合物、ジメチルマレエート等の1.2ージエステル系化合物、2ーヒドロキシー2ーメチルー1ーブチン等のアセチレンアルコール系化合物、単体の硫黄等の硫黄系化合物、トリエチルアミン等のアミン系化合物等が挙げられる。助触媒の添加量は特に限定されないが、触媒1モルに対して、10-2~102モルの範囲が好ましく、より好ましくは10-1~10モルの範囲である。

【0064】さらに本発明の組成物の保存安定性を改良 する目的、あるいは製造過程でのヒドロシリル化反応の 反応性を調整する目的で、硬化遅延剤を使用することが できる。硬化遅延剤としては、脂肪族不飽和結合を含有 する化合物、有機リン化合物、有機イオウ化合物、窒素 含有化合物、スズ系化合物、有機過酸化物等が挙げら れ、これらを併用してもかまわない。脂肪族不飽和結合 を含有する化合物として、プロパルギルアルコール類、 エンーイン化合物類、マレイン酸エステル類等が例示さ れる。有機リン化合物としては、トリオルガノフォスフ ィン類、ジオルガノフォスフィン類、オルガノフォスフ ォン類、トリオルガノフォスファイト類等が例示され る。有機イオウ化合物としては、オルガノメルカプタン 類、ジオルガノスルフィド類、硫化水素、ベンゾチアゾ 一ル、ペンゾチアゾールジサルファイド等が例示され る。窒素含有化合物としては、アンモニア、1~3級ア ルキルアミン類、アリールアミン類、尿素、ヒドラジン 等が例示される。スズ系化合物としては、ハロゲン化第 ースズ2水和物、カルボン酸第一スズ等が例示される。 有機過酸化物としては、ジーtーブチルペルオキシド、 ジクミルペルオキシド、ベンゾイルペルオキシド、過安 息香酸 t ーブチル等が例示される。

【0065】これらの硬化遅延剤のうち、遅延活性が良好で原料入手性がよいという観点からは、ベンゾチアゾール、チアゾール、ジメチルマレエート、3ーヒドロキシー3ーメチルー1ーブチンが好ましい。

【0066】硬化遅延剤の添加量は、使用するヒドロシ

リル化触媒 1 mol に対し、 $10^{-1} \sim 10^3$  モルの範囲が好ましく、より好ましくは  $1 \sim 50$  モルの範囲である。

【0067】次に(D)成分である金属原子及び/又は 半金属原子に結合した加水分解性基を1分子中に少なく とも2個含有する化合物、及び/又は、その部分縮合物 について説明する。

【〇〇68】(D)成分の金属原子としては長周期表においてBとAtを結ぶ線より左に位置する任意の原子を用いることができる。これらのうち、原料が工業的に入手しやすく工業的実用性が高いという点においては、AI、Zn、Ga、Ge、Sn、Mg、Ca、Ti、Zrが好ましく、AI、Tiがより好ましい。

【OO69】(D)成分の半金属原子としては長周期表においてBとAtを結ぶ線上あるいはそれに隣接する場所に位置する任意の原子を用いることができる。これらのうち、原料が工業的に入手しやすく工業的実用性が高いという点においては、B、Siが好ましく、Siがより好ましい。

【0070】これらの金属原子及び/又は半金属原子は 一種のものであってもよいし、複数のものを組み合わせ て用いてもよい。

【0071】(D)成分の金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基としては、加水分解縮合反応性を有する基であれば各種のものを用いることができるが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、トーブトキシ基、ちゅっプトキシ基、ペントキシ基、ヘキシロキシ基、ヘプチロキシ基、オクチロキシ基、ペンジロキシ基、フェノキシ基、シクロヘキシロキシ基、ベンジロキシ基、フェノキシ基、メトキシメトキシ基、2ーメトキシエトキシ基、

[0072]

【化11】

【0073】などのアルコキシ基、トリメチルシロキシ基、トリフェニルシロキシ基、ジメチルフェニルシロキシ基、ジメチル t ーブチルシロキシ基などのシロキシ基、ホルミロキシ基、アセチロキシ基、エチルカルボキシ基、プロピルカルボキシ基、フェニルカルボキシル基、メトキシカルボキシル基、フェノキシカルボキシル基などのアシロキシ基、クロロ基、ブロモ基などのハロゲン基、ジメチルアミノ基、ジフェニルアミノ基などのアミノ基などが挙げられる。

【0074】反応性が良好であり、ヒドロシリル化反応 を阻害し難いという点からは、アルコキシ基、シロキシ 基、アシロキシ基、ハロゲン基が好ましい。これらのう ち、アルコキシ基、シロキシ基がより好ましく、アシロキシ基、ハロゲン基の場合は酸性の揮発分を有するため 硬化時の金型を腐食するなどの問題がある。脱離基を揮 発により除去し易いという点においてはアルコキシ基が さらに好ましく、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポ キシ基、ブトキシ基が特に好ましい。

【OO75】上記したような(D)成分の例としては、 テトラメトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、ジ メチルジメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラ ン、ジフェニルジメトキシシラン、テトラフェノキシシ ラン、メチルトリフェノキシシラン、ジメチルジフェノ キシシラン、テトラエトキシシラン、メチルトリエトキ シシラン、ジメチルジエトキシシラン、フェニルトリエ トキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、テトラプ ロポキシシラン、テトラブトキシシランなどのアルコキ シシラン類、テトラアセトキシシランなどのアシロキシ シラン類、テトラ(トリメチルシロキシ)シランなどの シロキシシラン類、テトラクロロシラン、メチルトリク ロロシランなどのハロゲン化シラン類、アルミニウムト リメトキシド、アルミニウムトリエトキシド、アルミニ ウムトリイソプロポキシド、アルミニウムトリブトキシ ド、アルミニウムsec-ブトキシジイソプロポキシ ド、アルミニウムトリsec-ブトキシド、アルミニウ ムエチルアセトアセテートジイソプロポキシド、アルミ ニウムトリスエチルアセトアセテート、アルミニウムア セチルアセトネートビスエチルアセトアセテート、アル ミニウムトリスアセチルアセテートなどのアルミニウム アルコキシド類、塩化アルミニウムなどのハロゲン化ア ルミニウム類、テトラメトキシチタン、テトラエトキシ チタン、テトライソプロポキシチタン、テトラブトキシ チタンなどのアルコキシチタン類、四塩化チタンなどの ハロゲン化チタン類、ボロントリメトキシド、ボロント リエトキシド、ボロントリイソプロポキシド、ボロント リブトキシドなどのボロンアルコキシド類、ジルコニウ ムテトライソプロポキシドなどのジルコニウムアルコキ シド類、マグネシウムメトキシド、マグネシウムエトキ シド、マグネシウムイソプロポキシドなどのマグネシウ ムアルコキシド類、カルシウムメトキシド、カルシウム エトキシド、カルシウムイソプロポキシドなどのカルシ ウムアルコキシド類、ジメトキシ亜鉛、ジエトキシ亜 鉛、ジイソプロポキシ亜鉛などのアルコキシ亜鉛類な ど、およびそれらの部分縮合物などを挙げることができ る。

【0076】反応性が良好で、線膨張係数の低減化効果が高いという点においては、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシランが好ましく、反応性が良好で、得られる硬化物の靭性を損ない難いという観点からは、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシランが好ましい。

【OO77】(D)成分としては上記したようなものの

うち一種のものを用いてもよいし、複数のものを組み合わせて用いてもよい。

【 O O 7 8 】 (D) 成分の添加量としては任意の量を添加できるが、(D) 成分が加水分解縮合反応して得られるものの量が、全組成物中の5~7 0 重量%、好ましくは10~50重量%となるように添加することが好ましい。少ないと線膨張係数低減化効果が少ないし、多いと得られる硬化物が脆くなることがある。

【0079】(D)成分と合わせて金属原子及び/又は 半金属原子に結合した加水分解性基を一分子中に1個有 する化合物を併用してもよい。これらの化合物として は、例えばトリメチルメトキシシラン、トリメチルエト キシシラン、ジメチルフェニルメトキシシラン、ジメチ ルフェニルエトキシシラン、メチルジフェニルメトキシ シラン、メチルジフェニルエトキシシラン、トリフェニ ルエトキシシラン、トリフェニルメトキシシランなどの モノアルコキシシランを挙げることができる。

【OO80】次に(E)成分について説明する。

【 O O 8 1 】 (E) 成分としては水の他に水を生成する 化合物を用いることができる。水を生成する化合物とし ては、例えば、縮合により水を生成する、トリメチルシ ラノール、トリフェニルシラノールなどシラノール基を 有する化合物や、水を吸着したシリカ、結晶水を含む有 機及び/又は無機の結晶などを挙げることができる。

【0082】(E)成分としては上記したようなもののうち一種のものを用いてもよいし、複数のものを組み合わせて用いてもよい。

【0083】(E)成分の添加量としては任意の量を添加できるが、(E)成分から発生する水の量が、(D)成分のすべての加水分解性基を加水分解縮合するために必要な水の理論量に対して50~200モル%となる量が好ましく、80~120モル%となる量がより好ましい。少なくても多くても線膨張係数低減化効果が得られ難いことがある。

【OO84】次に(F)成分について説明する。

【〇〇85】本発明の組成物には必要に応じて(F)縮合触媒を含有させることができるが、縮合触媒として、は、塩酸、pートルエンスルホン酸、硫酸、酢酸、リフルオロ昨酸、トリフルオロ昨酸、トリフルオロ昨酸、トリフルオロ時酸は、塩化カリカル・ボロントがでは、塩化カリウム、ボロントリウムが、水酸化カリウム、サトリウムメインが、水酸化カリウム、サトリウムメインが、水酸化カリウム、カリカの水酸化物あるいはアルコキシド、カリ土類金属の水酸化物あるいはアルコキシド、カリ土類金属の水酸化物あるいはアルコキシド、ドロキシド、テトラアルルカリカロドロキシド、炭酸カリウス、ピリジン、ピラジン、ピリジン、ピリジン、ピリジン、ピロリジン、プチルアミン、ピリジン、ピロリジン、プチルアミン、ピリミジン、ピロリジン、紹合性を含まる。

ルアミン、ラウリルアミン、ジブチルアミン、モノエタ ノールアミン、トリエチレンテトラミン、オレイルアミ ン、シクロヘキシルアミン、ペンジルアミン、ジェチル アミノプロピルアミン、キシリレンジアミン、トリエチ レンジアミン、グアニジン、ジフェニルグアニジン、 2. 4. 6ートリス(ジメチルアミノメチル) フェノー ル、モルホリン、Nーメチルモルホリン、2ーエチルー 4-メチルイミダゾール、1,8-ジアザビシクロ [5. 4. 0] ウンデセンー7 (DBU) などのアミン 化合物、あるいはこれらアミン化合物のカルボン酸など との塩、過剰のポリアミンと多塩基酸とから得られる低 分子量ポリアミド樹脂、過剰のポリアミンとエポキシ化 合物との反応生成物、アーアミノプロピルトリメトキシ シラン、N-(β-アミノエチル) アミノプロピルメチ ルジメトキシシランなどのアミノ基を有するシランカッ プリング剤などが挙げられる。また、テトラブチルアン モニウムフルオライド、フッ化カリウム、フッ化ナトリ ウムなどのフッ素系化合物なども用いることができる。 その他、Sn、Sb、Zn、Fe、Co、Ti、Al、 Zr、Bなどの有機酸塩、アルコキシド、キレートとい った各種金属系縮合触媒など、従来公知の縮合触媒(シ ラノール縮合触媒)が挙げられる。Sn系縮合触媒の具 体例としては、錫(11)メトキシド、錫(11)エト キシド、錫(11)2、4ーペンタンジオネート、錫 (II) オクトエート、酢酸錫(II)、ジブチル錫ジ ラウレート、ジブチル錫マレート、ジブチル錫ジアセテ ート、ナフテン酸錫、ジブチル錫オキサイドとフタル酸 エステルとの反応物、ジブチル錫ジアセチルアセトナー トなどが挙げられ、Sb系縮合触媒の具体例としては、 鉛(II)ヘキサフルオロペンタンジオネート、鉛(I 1) 2, 4-ペンタンジオネート、鉛(11) 2, 2, 6, 6-テトラメチルー3, 5-ヘプタンジオネート、 オクチル酸鉛などが挙げられ、Zn系縮合触媒の具体例 としては、ジメトキシ亜鉛、ジエトキシ亜鉛、亜鉛メト キシエトキシド、亜鉛2、4ーペンタンジオネート、酢 酸亜鉛、亜鉛2-エチルヘキサノエート、ギ酸亜鉛、メ タクリル酸亜鉛、亜鉛ネオデカノエート、ウンデシレン 酸亜鉛、オクチル酸亜鉛などが挙げられ、Fe系縮合触 媒の具体例としては、鉄(III)ベンゾイルアセトネ ート、鉄(III) エトキサイド、鉄(III) 2, 4 ーペンタンジオネート、鉄(III)トリフルオロペン タンジオネート、オクチル酸鉄などが挙げられ、Co系 縮合触媒の具体例としては、コバルト(II) 2, 4-ペンタンジオネート、コバルト(III)2、4ーペン タンジオネートなどが挙げられ、Ti系縮合触媒の具体 例としては、ジイソプロポキシビス(アセト酢酸エチ ル)チタン、ジイソプロポキシビス(アセト酢酸メチ ル)チタン、ジイソプロポキシピス(アセチルアセト ン)チタン、ジブトキシピス(アセト酢酸エチル)チタ ンなどが挙げられ、AI系縮合触媒の具体例としては、

アルミニウムトリイソプロポキシド、アルミニウムトリ 第2ブトキシド、アルミニウムジイソプロポキシ第2ブ トキシド、アルミニウムジイソプロポキシドアセチルア セトナート、アルミニウムジ第2ブトキシドアセチルア セトナート、アルミニウムジイソプロポキシドエチルア セトアセテート、アルミニウムジ第2ブトキシドエチル アセトアセテートなどが挙げられ、Zr系縮合触媒の具 体例としては、ジルコニウムテトラブトキシド、ジルコ ニウムテトライソプロポキシド、ジルコニウムテトラメ トキシド、ジルコニウムトリブトキシドモノアセチルア セトナート、ジルコニウムジブトキシドビスアセチルア セトナート、ジルコニウムモノブトキシドトリスアセチ ルアセトナート、ジルコニウムトリブトキシドモノエチ ルアセトアセテート、ジルコニウムジブトキシドビスエ チルアセトアセテート、ジルコニウムモノブトキシドト リスエチルアセトアセテート、ジルコニウムテトラアセ チルアセトナート、ジルコニウムテトラエチルアセトア セテートなどが挙げられ、B系縮合触媒の具体例として は、ホウ素メトキシド、ホウ素エトキシド、ホウ素n-ブトキシドなどが挙げられる。

【0086】これらのうち、ヒドロシリル化反応を阻害し難いという点からは、中性の有機金属化合物が好ましく、さらに好ましくはTi系縮合触媒およびAI系縮合触媒であり、特に好ましい触媒はTi系縮合触媒である。

【OO87】(F)成分としては上記したようなもののうち一種のものを用いてもよいし、複数のものを組み合わせて用いてもよい。

【0088】(F)成分の添加量としては任意の量を添加できるが、(D)成分100重量部に対して0.01~20重量部が好ましく、0.3~10重量部がより好ましい。少ないと得られる硬化物に線膨張係数低減化効果が得られ難い場合があり、多いと着色する場合がある。

【0089】本発明の組成物としては上記したように各種組み合わせのものが使用できるが、耐熱性が良好であるという観点から、組成物を硬化させて得られる硬化物のTgが50℃以上となるものが好ましく、100℃以上となるものがさらに好ましく、150℃以上となるものが特に好ましい。

【〇〇9〇】本発明の組成物をそのままフィルムなどに成形することも可能であるが、該組成物を有機溶剤に溶解してワニスとすることも可能である。使用できる溶剤は特に限定されるものではなく、具体的に例示すれば、ベンゼン、トルエン、ヘキサン、ヘプタンなどの炭化水素系溶媒、テトラヒドロフラン、1、4ージオキサン、ジエチルエーテルなどのエーテル系溶媒、クロロホルム、メチルエチルケトンなどのケトン系溶媒、クロロホルム、塩化メチレン、1、2ージクロロエタンなどのハロゲン系溶媒を好適に用いることができる。溶媒は2種類以上

の混合溶媒として用いることもできる。溶媒としては、トルエン、テトラヒドロフラン、クロロホルムが好ましい。使用する溶媒量は、用いる(A)成分1gに対し、0~10mLの範囲で用いるのが好ましく、0.5~5mLの範囲で用いるのがさらに好ましく、1~3mLの範囲で用いるのが特に好ましい。使用量が少ないと、低粘度化などの溶媒を用いることの効果が得られにくく、また、使用量が多いと、材料に溶剤が残留して熱クラックなどの問題となり易く、またコスト的にも不利になり工業的利用価値が低下する。

【〇〇91】本発明の組成物には、その他、老化防止 剤、ラジカル禁止剤、紫外線吸収剤、接着性改良剤、難 燃剤、界面活性剤、保存安定改良剤、オゾン劣化防止 剤、光安定剤、増粘剤、可塑剤、カップリング剤、酸化 防止剤、熱安定剤、導電性付与剤、帯電防止剤、放射線 遮断剤、核剤、リン系過酸化物分解剤、滑剤、顔料、金 属不活性化剤、物性調整剤などを本発明の目的および効 果を損なわない範囲において添加することができる。な お、カップリング剤としては例えばシランカップリング 剤が挙げられる。シランカップリング剤としては、分子 中に有機基と反応性のある官能基と加水分解性のケイ素 基を各々少なくとも1個有する化合物であれば特に限定 されない。有機基と反応性のある基としては、取扱い性 の点からエポキシ基、メタクリル基、アクリル基、イソ シアネート基、イソシアヌレート基、ビニル基、カルバ メート基から選ばれる少なくとも1個の官能基が好まし く、硬化性及び接着性の点から、エポキシ基、メタクリ ル基、アクリル基が特に好ましい。加水分解性のケイ素 基としては取扱い性の点からアルコキシシリル基が好ま しく、反応性の点からメトキシシリル基、エトキシシリ ル基が特に好ましい。好ましいシランカップリング剤と しては、3ーグリシドキシプロピルトリメトキシシラ ン、3-グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、2 - (3, 4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリメト キシシラン、2-(3,4-エポキシシクロヘキシル) エチルトリエトキシシラン等のエポキシ官能基を有する アルコキシシラン類:3-メタクリロキシプロピルトリ メトキシシラン、3ーメタクリロキシプロピルトリエト キシシラン、3-アクリロキシプロピルトリメトキシシ ラン、3-アクリロキシプロピルトリエトキシシラン、 メタクリロキシメチルトリメトキシシラン、メタクリロ キシメチルトリエトキシシラン、アクリロキシメチルト リメトキシシラン、アクリロキシメチルトリエトキシシ ラン等のメタクリル基あるいはアクリル基を有するアル コキシシラン類が例示できる。

【0092】さらに、本発明の組成物には種々の発光ダイオード特性改善のための添加剤を添加してもよい。添加剤としては例えば、発光素子からの光を吸収してより長波長の蛍光を出す、セリウムで付活されたイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体等の蛍光体や、

特定の波長を吸収するブルーイング剤等の着色剤、光を拡散させるための酸化チタン、酸化アルミニウム、シリカ、石英ガラス等の酸化ケイ素、タルク、炭酸カルシウム、メラミン樹脂、CTUグアナミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂等のような各種無機あるいは有機拡散材、ガラス、アルミノシリケート等の金属酸化物、窒化アルミニウム、窒化ボロン等の金属窒化物等の熱伝導性フィラー等を挙げることができる。

【0093】発光ダイオード特性改善のための添加剤は 均一に含有させても良いし、含有量に傾斜を付けて含有 させてもよい。この様なフィラー含有樹脂部は発光面前 面のモールド部材用の樹脂を型に流した後、引き続い て、フィラーを含有させた樹脂を流し発光面後方のモー ルド部材として形成させることができる。また、モール ド部材形成後リード端子を表裏両面からテープを張り付 けることによって覆い、この状態でリードフレーム全体 をフィラー含有樹脂を溜めたタンク内に発光ダイオード のモールド部材の下半分を浸漬した後、引き上げて乾燥 させフィラー含有樹脂部を形成させても良い。

【0094】本発明で言う光学材料とは、可視光、赤外線、紫外線、X線、レーザーなどの光をその材料中を通過させる用途に用いる材料一般を示す。

【0095】より具体的には、液晶ディスプレイ分野に おける基板材料、導光板、プリズムシート、偏向板、位 相差板、視野角補正フィルム、接着剤、偏光子保護フィ ルムなどの液晶用フィルムなどの液晶表示装置周辺材料 である。また、次世代フラットパネルディスプレイとし て期待されるカラーPDP(プラズマディスプレイ)の 封止材、反射防止フィルム、光学補正フィルム、ハウジ ング材、前面ガラスの保護フィルム、前面ガラス代替材 料、接着剤;また発光ダイオード表示装置に使用される 発光索子のモールド材、発光ダイオードの封止材、前面 ガラスの保護フィルム、前面ガラス代替材料、接着剤; またプラズマアドレス液晶(PALC)ディスプレイに おける基板材料、導光板、プリズムシート、偏向板、位 相差板、視野角補正フィルム、接着剤、偏光子保護フィ ルム;また有機EL(エレクトロルミネッセンス)ディ スプレイにおける前面ガラスの保護フィルム、前面ガラ ス代替材料、接着剤: またフィールドエミッションディ スプレイ(FED)における各種フィルム基板、前面ガ ラスの保護フィルム、前面ガラス代替材料、接着剤であ る。

【 O O 9 6】光記録分野では、V D (ビデオディスク)、C D / C D - R O M、C D - R / R W、D V D - R / D V D - R A M、M O / M D、P D (相変化ディスク)、光カード用のディスク基板材料、ピックアップレンズ、保護フィルム、封止材、接着剤などである。

【〇〇97】光学機器分野では、スチールカメラのレンズ用材料、ファインダプリズム、ターゲットプリズム、ファインダーカバー、受光センサー部である。また、ビ

デオカメラの撮影レンズ、ファインダーである。またプロジェクションテレビの投射レンズ、保護フィルム、封止材、接着剤などである。光センシング機器のレンズ用材料、封止材、接着剤、フィルムなどである。

【QO98】光部品分野では、光通信システムでの光スイッチ周辺のファイバー材料、レンズ、導波路、素子の封止材、接着剤などである。光コネクタ周辺の光ファイバー材料、フェルール、封止材、接着剤などである。光受動部品、光回路部品ではレンズ、導波路、発光素子の封止材、接着剤などである。光電子集積回路(OEIC)周辺の基板材料、ファイバー材料、素子の封止材、接着剤などである。

【0099】光ファイバー分野では、装飾ディスプレイ 用照明・ライトガイドなど、工業用途のセンサー類、表示・標識類など、また通信インフラ用および家庭内のデジタル機器接続用の光ファイバーである。

【0100】半導体集積回路周辺材料では、LSI、超 LSI材料用のマイクロリソグラフィー用のレジスト材 料である。

【 O 1 O 1 】自動車・輸送機分野では、自動車用のランプリフレクタ、ベアリングリテーナー、ギア部分、耐蝕コート、スイッチ部分、ヘッドランプ、エンジン内部品、電装部品、各種内外装品、駆動エンジン、ブレーキオイルタンク、自動車用防錆鋼板、インテリアパネル、内装材、保護・結束用ワイヤーネス、燃料ホース、自動車ランプ、ガラス代替品である。また、鉄道車輌用の複層ガラスである。また、航空機の構造材の靱性付与剤、エンジン周辺部材、保護・結束用ワイヤーネス、耐蝕コートである。

【0102】建築分野では、内装・加工用材料、電気カバー、シート、ガラス中間膜、ガラス代替品、太陽電池 周辺材料である。農業用では、ハウス被覆用フィルムである。

【0103】次世代の光・電子機能有機材料としては、有機EL素子周辺材料、有機フォトリフラクティブ素子、光一光変換デバイスである光増幅素子、光演算素子、有機太陽電池周辺の基板材料、ファイバー材料、素子の封止材、接着剤などである。

【0104】本発明の光学材料用組成物は、あらかじめ混合し、組成物中のSiH基と反応性を有する炭素一炭素二重結合とSiH基の一部または全部を反応させ、金属原子及び/又は半金属原子に結合した加水分解性基を加水分解縮合反応させることによって硬化させて光学材料とすることができる。

【 O 1 O 5 】混合の方法としては、各種方法をとることができるが、 (A) 成分に (C) 成分、 (E) 成分を混合したものと、 (B) 成分に (D) 成分を混合したものとを混合する方法が好ましい。 (A) 成分、 (B) 成分、 (D) 成分、 (E) 成分の混合物に (C) 成分を混合する方法だと反応の制御が困難である。 (B) 成分に

(C)成分、(D)成分を混合したものに(A)成分に(E)成分を混合したものを混合する方法をとる場合は、(C)成分の存在下(B)成分が環境中の水分と反応性を有するため、貯蔵中などに変質することもある。

(B) 成分と(E) 成分を混合した状態で保存すると、 貯蔵中などに変質することもあるため、これらは別のコ ンポーネントに含有させるほうが好ましい。(F) 成分 を用いる場合には、(F) 成分と(D) 成分あるいは、

(F) 成分と(E) 成分が反応性が高い場合があるので、これらの成分は分けて混合することが好ましい。具体的には(A) 成分に(C) 成分、(F) 成分を混合したものと、(B) 成分に(D) 成分、(E) 成分を混合したものを混合する方法や、(A) 成分に(C) 成分、

(D)成分、(E)成分を混合したものと、(B)成分に(F)成分を混合したものを混合する方法が好ましい。

【0106】組成物を反応させて硬化させる場合において、(A)、(B)、(C)各成分、あるいは(D)、(E)、(必要に応じて(F))各成分のそれぞれの必要量を一度に混合して反応させてもよいが、一部を混合して反応させた後残量を混合してさらに反応させる方法や、混合した後反応条件の制御や置換基の反応性の差の利用により組成物中の官能基の一部のみを反応(Bステージ化)させてから成形などの処理を行いさらに硬化させる方法をとることもできる。これらの方法によれば成形時の粘度調整が容易となる。

【0107】硬化させる方法としては、単に混合するだけで反応させることもできるし、加熱して反応させることもできる。反応が速く、一般に耐熱性の高い材料が得られやすいという観点から加熱して反応させる方法が好ましい。

【0108】この場合、(A)、(B)、(C)成分のヒドロシリル化反応と、(D)、(E)、必要に応じて(F)成分の加水分解縮合反応は、どちらかを優先的に反応させることもできるが、得られる硬化物がより透明になりやすいという点においては同時並行的に進行させる方が好ましい。同時並行的に進行させるためには、必要成分を徐々に添加する方法によることもできるが、

(C)成分の含有量や、(F)成分の含有量や、反応温度をそれぞれ調整することによっても可能であり、後者の方が簡便である。

【0109】反応温度としては種々設定できるが、例えば30~300℃の温度が適用でき、100~250℃がより好ましく、150~200℃がさらに好ましい。反応温度が低いと十分に反応させるための反応時間が長くなり、反応温度が高いと成形加工が困難となりやすい。

【 O 1 1 O 】 反応は一定の温度で行ってもよいが、必要 に応じて多段階あるいは連続的に温度を変化させてもよ い。一定の温度で行うより多段階的あるいは連続的に温 度を上昇させながら反応させた方が、歪のない均一な硬 化物が得られやすいという点において好ましい。

【 O 1 1 1】反応時間も種々設定できるが、高温短時間で反応させるより、比較的低温長時間で反応させた方が、歪のない均一な硬化物が得られやすいという点において好ましい。

【 O 1 1 2 】反応時の圧力も必要に応じ種々設定でき、常圧、高圧、あるいは減圧状態で反応させることもできる。加水分解縮合により発生する揮発分を除きやすいという点においては、減圧状態で反応させることが好ましい。

【0113】硬化させて得られる光学材料の形状も用途に応じて種々とりうるので特に限定されないが、例えばフィルム状、シート状、チューブ状、ロッド状、塗膜状、パルク状などの形状とすることができる。

【0114】成形する方法も従来の熱硬化性樹脂の成形方法をはじめとして種々の方法をとることができる。例えば、キャスト法、プレス法、注型法、トランスファ成形法、コーティング法、RIM法などの成形方法を適用することができる。成形型は研磨ガラス、硬質ステレス研磨板、ポリカーボネート板、ポリエチレンテレフタレート板等を適用することができる。また、成形型との離型性を向上さるとができる。また、成形型との離型性を向上さるとができる。また、成形型とのないよポリカーボンフィルム、ポリテトラフルオロエチレンフィルム、ポリエチンフィルム、ポリテトラフルオロエチレンフィルム、ポリテトラフルオロエチレンフィルム、ポリテトラフルオロエチレンフィルム、ポリイミドフィルム等を適用することができる。

【 O 1 1 5 】成形時に必要に応じ各種処理を施すこともできる。例えば、成形時に発生するボイドの抑制のために組成物あるいは一部反応させた組成物を遠心、減圧などにより脱泡する処理、プレス時に一旦圧力を開放する処理などを適用することもできる。

【O116】本発明の光学材料を用いて液晶表示装置を 製造することができる。

【 0 1 1 7 】 この場合、本発明の光学材料を液晶用プラスチックセル、偏光板、位相差板、偏光子保護フィルムなどの液晶用フィルムとして使用し、通常の方法によって液晶表示装置を製造すればよい。

【 O 1 1 8 】本発明の光学材料を用いて発光ダイオードを製造することができる。この場合、発光ダイオードは上記したような組成物によって発光素子を被覆することによって製造することができる。

【O119】この場合発光素子とは、特に限定なく従来公知の発光ダイオードに用いられる発光素子を用いることができる。このような発光素子としては、例えば、MOCVD法、HDVPE法、液相成長法といった各種方法によって、必要に応じてGaN、AIN等のバッファー層を設けた基板上に半導体材料を積層して作成したものが挙げられる。この場合の基板としては、各種材料を

用いることができるが、例えばサファイア、スピネル、SiC、Si、ZnO、GaN単結晶等が挙げられる。これらのうち、結晶性の良好なGaNを容易に形成でき、工業的利用価値が高いという観点からは、サファイアを用いることが好ましい。

【O120】積層される半導体材料としては、GaAs、GaP、GaAIAs、GaAsP、AIGaInP、GaN、InN、AIN、InGaN、InGaAIN、SiC等が挙げられる。これらのうち、高輝度が得られるという観点からは、窒化物系化合物半導体(InxGayAIzN)が好ましい。このような材料には付活剤等を含んでいてもよい。

【0121】発光索子の構造としては、MIS接合、pn接合、PIN接合を有するホモ接合、ヘテロ接合やダブルヘテロ構造等が挙げられる。また、単一あるいは多重量子井戸構造とすることもできる。

【 O 1 2 2 】 発光素子はパッシベーション層を設けていてもよいし、設けなくてもよい。

【0123】発光索子には従来知られている方法によって電極を形成することができる。

【0124】発光素子上の電極は種々の方法でリード端子等と電気接続できる。電気接続部材としては、発光素子の電極とのオーミック性機械的接続性等が良いものが好ましいく、例えば、金、銀、銅、白金、アルミニウムやそれらの合金等を用いたボンディングワイヤーが挙げられる。また、銀、カーボン等の導電性フィラーを樹脂で充填した導電性接着剤等を用いることもできる。これらのうち、作業性が良好であるという観点からは、アルミニウム線或いは金線を用いることが好ましい。

【0125】上記のようにして発光素子が得られるが、本発明の発光ダイオードにおいては発光素子の光度としては垂直方向の光度が1cd以上であれば任意のものを用いることができるが、垂直方向の光度が2cd以上の発光素子を用いた場合により本発明の効果が顕著であり、3cd以上の発光素子を用いた場合にさらに本発明の効果が顕著である。

【0126】発光素子の発光出力としては特に限定なく任意のものを用いることができるが、20mAにおいて1mW以上の発光素子を用いた場合に本発明の効果が顕著であり、20mAにおいて4mW以上の発光素子を用いた場合により本発明の効果が顕著であり、20mAにおいて5mW以上の発光素子を用いた場合にさらに本発明の効果が顕著である。

【 0 1 2 7 】 発光素子の発光波長は紫外域から赤外域まで種々のものを用いることができるが、主発光ピーク波長が5 5 0 n m以下のものを用いた場合に特に本発明の効果が顕著である。

【 O 1 2 8 】用いる発光索子は一種類で単色発光させても良いし、複数用いて単色或いは多色発光させても良い。

【0129】本発明の発光ダイオードに用いられるリー ド端子としては、ボンディングワイヤー等の電気接続部 材との密着性、電気伝導性等が良好なものが好ましく、 リード端子の電気抵抗としては、 $300 \mu\Omega$  - cm以下 が好ましく、より好ましくは3μΩーcm以下である。 これらのリード端子材料としては、例えば、鉄、銅、鉄 入り銅、錫入り銅や、これらに銀、ニッケル等をメッキ したもの等が挙げられる。これらのリード端子は良好な 光の広がりを得るために適宜光沢度を調整してもよい。 【0130】本発明の発光ダイオードは上記したような 組成物によって発光索子を被覆することによって製造す ることができるが、この場合被覆とは、上記発光索子を 直接封止するものに限らず、間接的に被覆する場合も含 む。具体的には、発光素子を本発明の組成物で直接従来 用いられる種々の方法で封止してもよいし、従来用いら れるエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、ユ リア樹脂、イミド樹脂等の封止樹脂やガラスで発光素子 を封止した後に、その上あるいは周囲を本発明の組成物 で被覆してもよい。また、発光素子を本発明の組成物で 封止した後、従来用いられるエポキシ樹脂、シリコーン 樹脂、アクリル樹脂、ユリア樹脂、イミド樹脂等でモー ルディングしてもよい。以上のような方法によって屈折 率や比重の差によりレンズ効果等の種々の効果をもたせ

ることも可能である。

【0131】封止の方法としても各種方法を適用するこ とができる。例えば、底部に発光素子を配置させたカッ プ、キャビティ、パッケージ凹部等に液状の組成物をデ ィスペンサーその他の方法にて注入して加熱等により硬 化させてもよいし、固体状あるいは高粘度液状の組成物 を加熱する等して流動させ同様にパッケージ凹部等に注 入してさらに加熱する等して硬化させてもよい。この場 合のパッケージは種々の材料を用いて作成することがで き、例えば、ポリカーボネート樹脂、ポリフェニレンス ルフィド樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、シリコー ン樹脂、ABS樹脂等を挙げることができる。また、モ 一ルド型枠中に組成物をあらかじめ注入し、そこに発光 索子が固定されたリードフレーム等を浸漬した後硬化さ せる方法も適用することができるし、発光索子を挿入し た型枠中にディスペンサーによる注入、トランスファー 成形、射出成形等により組成物による封止層を成形、硬 化させてもよい。さらに、単に液状または流動状態とし た組成物を発光索子上に滴下あるいはコーティングして 硬化させてもよい。あるいは、発光索子上に孔版印刷、 スクリーン印刷、あるいはマスクを介して塗布すること 等により組成物を成形させて硬化させることもできる。 その他、あらかじめ板状、あるいはレンズ形状等に部分 硬化あるいは硬化させた組成物を発光素子上に固定する 方法によってもよい。さらには、発光索子をリード端子 やパッケージに固定するダイボンド剤として用いること もできるし、発光索子上のパッシベーション膜として用 いることもできる。また、パッケージ基板として用いることもできる。

【 O 1 3 2 】被覆部分の形状も特に限定されず種々の形状をとることができる。例えば、レンズ形状、板状、薄膜状、特開平 6 - 2 4 4 4 5 8 記載の形状等が挙げられる。これらの形状は組成物を成形硬化させることによって形成してもよいし、組成物を硬化した後に後加工により形成してもよい。

【0133】本発明の発光ダイオードは、種々のタイプとすることができ、例えば、ランプタイプ、SMDタイプ、チップタイプ等いずれのタイプでもよい。SMDタイプ、チップタイプのパッケージ基板としては、種々のものが用いられ、例えば、エポキシ樹脂、BTレジン、セラミック等が挙げられる。

【0134】その他、本発明の発光ダイオードには従来 公知の種々の方式が適用できる。例えば、発光素子背面 に光を反射あるいは集光する層を設ける方式、封止樹脂 の黄変に対応して補色着色部を底部に形成させる方式、 主発光ピークより短波長の光を吸収する薄膜を発光素子 上に設ける方式、発光索子を軟質あるいは液状の封止材 で封止した後周囲を硬質材料でモールディングする方 式、発光索子からの光を吸収してより長波長の蛍光を出 す蛍光体を含む材料で発光索子を封止した後周囲をモー ルディングする方式、蛍光体を含む材料をあらかじめ成 形してから発光素子とともにモールドする方式、特開平 6-244458に記載のとおりモールディング材を特 殊形状として発光効率を高める方式、輝度むらを低減さ せるためにパッケージを2段状の凹部とする方式、発光 ダイオードを貫通孔に挿入して固定する方式、発光索子 表面に主発光波長より短い波長の光を吸収する薄膜を形 成する方式、発光素子をはんだパンプ等を用いたフリッ プチップ接続等によってリード部材等と接続して基板方 向から光を取出す方式、等を挙げることができる。

【 O 1 3 5 】本発明の発光ダイオードは従来公知の各種の用途に用いることができる。具体的には、例えばバックライト、照明、センサー光源、車両用計器光源、信号灯、表示灯、表示装置、面状発光体の光源、ディスプレイ、装飾、各種ライト等を挙げることができる。

[0136]

【実施例】以下に、本発明の実施例および比較例を示す が、本発明は以下によって限定されるものではない。

(合成例1) 1 Lの3つロフラスコに、撹拌装置、冷却管をセットした。このフラスコに、ビスフェノールA114g、炭酸カリウム145g、アリルブロマイド140g、アセトン250mLを入れ、60℃で12時間撹拌した。上澄み液をとり、分液ロートで水酸化ナトリウム水溶液により洗浄し、その後水洗した。油層を硫酸ナトリウムで乾燥させた後、エパポレーターで溶媒を留去したところ、淡黄色の液体126gが得られた。1HーNMRにより、ビスフェノールAのOH基がアリルエー

テル化したビスフェノールAジアリルエーテルであることがわかった。収率は82%であり純度は95%以上であった。

【0137】(合成例2)1Lの4つロフラスコに、攪 拌装置、冷却管、滴下漏斗をセットした。このフラスコ にトルエン150g、白金ピニルシロキサン錯体のキシ レン溶液 (白金として3wt%含有) 15. 6μL、 1, 3, 5, 7ーテトラメチルシクロテトラシロキサン 500gを加えてオイルパス中で70℃に加温、攪拌し た。合成例1で製造したビスフェノールAジアリルエー テル64gをトルエン40gで希釈して滴下漏斗から滴 下した。同温で60分攪拌後放冷し、ベンゾチアゾール 4. 74mgを添加した。未反応の1, 3, 5, 7ーテ トラメチルシクロテトラシロキサンおよびトルエンを減 圧留去し、やや粘ちょうな液体を得た。「H-NMRに よりこのものは1、3、5、7ーテトラメチルシクロテ トラシロキサンのSiH基の一部がビスフェノールAジ アリルエーテルと反応したもの(部分反応物Aと称す) であることがわかった。

【0138】(合成例3)200mLの二ロフラスコに、磁気攪拌子、冷却管をセットした。このフラスコにトルエン50g、白金ピニルシロキサン錯体のキシレン溶液(白金として3wt%含有)11.3µL、トリアリルイソシアヌレート5.0g、1,3,5,7ーテトラメチルシクロテトラシロキサン37.04gを加えて、90℃のオイルバス中で30分加温、攪拌した。さらに130℃のオイルバス中で2時間加熱還流させた。1ーエチニルー1ーシクロヘキサノール176mgを加えた。未反応の1,3,5,7ーテトラメチルシクロテトラシロキサンおよびトルエンを減圧留去した。<sup>1</sup>HーNMRによりこのものは1,3,5,7ーテトラメチルシクロテトラシロキサンのSiH基の一部がトリアリルイソシアヌレートと反応したもの(部分反応物Bと称す)であることがわかった。

【0139】(実施例1)合成例1で製造したビスフェノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製造した部分反応物A15.4gと、テトラメトキシジラン3.1gと、水1.0gと、ジイソプロポキシビス(アセト酢酸メチル)チタン0.5gと、THF3mlとをカップ中で混合した。合成例2で示したようにおかり反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有している。このものをポリイミドコイルムをひいた軟音缶中に流し込み、50℃/15時間、100℃/17時間、さらに150℃/24時間加熱を行い、目視でわずかに白濁した無色のほぼ透明なフィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有しないものであった。

【0140】 (実施例2) 合成例1で製造したピスフェノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製造した部分反応物A15.4gと、テトラメトキシシラ

ン15.8gと、水2.7gと、ジイソプロポキシビス (アセト酢酸メチル) チタン2.0gと、THF3mIとをカップ中で混合した。合成例2で示したように部分 反応物Aは本発明の (C) 成分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有している。このものをポリイミドフィルムをひいた軟膏缶中に流し込み、 $50^{\circ}$  / 15時間、 $80^{\circ}$  / 17時間、さらに150 $^{\circ}$  / 24時間加熱を行い、目視でわずかに白濁した無色のフィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有しないものであった。

【0141】(実施例3)合成例1で製造したビスフェノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製造した部分反応物A15.4gと、テトラエトキシシラン3.1gと、水1.0gと、ジイソプロポキシビス(アセト酢酸メチル)チタン0.5gと、THF3mlとをカップ中で混合した。合成例2で示したようにお分反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有している。このものをポリイミドコイルムをひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時間、80℃/7時間、100℃/17時間、さらに150℃/24時間加熱を行い、やや黄色であるが透明なフィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有しないものであった。

【 O 1 4 2 】 (実施例 4 ) 合成例 1 で製造したビスフェノールAジアリルエーテル 1 6 . 1 gと、合成例 2 で製造した部分反応物 A 1 5 . 4 gと、テトラエトキシシラン 1 5 . 8 gと、水 2 . 7 gと、ジイソプロポキシビス(アセト酢酸メチル)チタン 2 . 0 gと、THF3mlとをカップ中で混合した。合成例 2 で示したようにおり反応物 A は本発明の(C)成分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有している。このものをポリイミドコイルムをひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時間、80℃/7時間、100℃/17時間、さらに150℃/24時間加熱を行い、やや黄色であるが透明なフィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有しないものであった。

【0143】(実施例5)合成例1で製造したビスフェノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製造した部分反応物A15.4gと、ポロントリメトキシド15.8gと、水2.7gと、ジイソプロポキシビス(アセト酢酸メチル)チタン2.0gと、THF2mlとをカップ中で混合した。合成例2で示したように部分反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有している。このものをポリイミドフィルムをひいた軟音缶中に流し込み、50℃/15時間、さらに150℃/24時間加熱を行い、やや褐色であるが透明なフィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有しないものであった。

【0144】 (実施例6) 合成例1で製造したビスフェ

ノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製造した部分反応物A15.4gと、ボロントリエトキシド15.8gと、水2.7gと、ジイソプロポキシビス(アセト酢酸メチル)チタン2.0gと、THF2mlとをカップ中で混合した。合成例2で示したように部分反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有している。このものをポリイミドフィルムをひいた軟音缶中に流し込み、50℃/15時間、100℃/17時間、さらに150℃/24時間加熱を行い、やや褐色であるが透明なフィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有しないものであった。

【0146】(実施例8)合成例1で製造したビスフェノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製造した部分反応物A15.4gと、メチルトリメトキシシランの部分縮合物(オーエンスイリノイ社製GR650)3.2gと、水1.2gと、ジイソプロポキシビス(アセト酢酸メチル)チタン1.8gと、THF2mlとをカップ中で混合した。合成例2で示したようにおり反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有している。このものをポリイ15時間、カムをひいた軟膏缶中に流し込み、50 $^{\circ}$ ン/15時間、100 $^{\circ}$ ン/17時間、さらに150 $^{\circ}$ ン/24時間加熱を行い、目視でわずかに白濁した無色のフィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有しないものであった。

 化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有し ないものであった。

【0148】(比較例2)合成例1で製造したビスフェノールAジアリルエーテル16.1gと、合成例2で製造した部分反応物A15.4gと、THF2m1とをカップ中で混合した。合成例2で示したように部分反応物Aは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有している。このものをポリイミドフィルムをひいた軟膏缶中に流し込み、50℃/15時間、80℃/7時間、100℃/17時間、さらに150℃/24時間加熱を行い、透明なフィルム状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有しないものであった。

【0149】(測定例1) 実施例3、5、8および比較例2で作成した硬化物の線膨張係数を測定した。線膨張係数は熱機械分析装置を用いて実施した。測定条件としては、フィルム状サンプルを3×15mmの短冊状に切り出し、チャック間10mm、荷重3gの引張りモードにて、窒素気流下において昇温速度10℃/分として測定し、40℃から60℃における平均線膨張係数を測定値とした。結果は表1に示した。

【0150】 【表1】

	線膨張係数 (ppm)
実施例3	72
実施例5	82
実施例8	70
比較例2	100

【O151】表1で示すとおり本発明の実施例では線膨 張係数が低減している。

【0152】(実施例9)トリアリルイソシアヌレート 2.5 g と、合成例3で合成した部分反応物B3.0 g と、テトラメトキシシラン3.1 g と、水1.0 g と、ジイソプロポキシビス(アセト酢酸メチル)チタン0.3 g と、THF3 m I とをカップ中で混合し、組成物とした。合成例3で示したように部分反応物Bは本発明の(C)成分としての白金ビニルシロキサン錯体を含有している。このものを、2 枚のガラス板に0.5 mm厚みのシリコーンゴムシートをスペーサーとしてはさみこんで作成したセルに流し、80 $^{\circ}$ ~ $^{\circ}$ 60分、100 $^{\circ}$ ~ $^{\circ}$ 60分、120 $^{\circ}$ ~ $^{\circ}$ 60分加熱を行いほぼ無色透明のシート状硬化物を得た。得られた硬化物は硬質で表面タックを有しないものであった。

【 0 1 5 3 】 (測定例 2 ) 実施例 9 で作成した硬化物を、スガ試験機製の S X 1 2 0 型キセノンウェザーメーター (ブラックパネル温度 6 3 ℃、照射 2 時間中降雨 1 8 分) にて 7 0 時間照射して硬化物が着色するかどうかを調べたところ、着色がみられず無色透明の状態を保った。本発明の組成物は優れた耐光性を有している。

【0154】 (実施例10) 実施例9のようにして作成 したシート状硬化物を適当な形状に切断し、キャンタイ プ用の金属キャップに設けた光透過用窓の部分に固定す る。一方で、MOCVD(有機金属気相成長)法により サファイア基板上に形成した、SiとZnがドープされ たInGaN活性層をn型とp型のAIGaNクラッド 層で挟んだダブルヘテロ構造の発光索子を用意する。続 いて、この発光素子をキャンタイプ用の金属のステムに 載置した後、p電極、n電極をそれぞれのリードにAu 線でワイヤーボンディングする。これを上記のキャンタ イプ用の金属キャップで気密封止する。この様にしてキ ャンタイプの発光ダイオードを作成することができる。 【0155】 (実施例11) 洗浄したサファイア基板上 にMOCVD(有機金属気相成長)法により、アンドー プの窒化物半導体であるn型GaN層、Siドープのn 型電極が形成されn型コンタクト層となるGaN層、ア 層を構成するバリア層となるGaN層、井戸層を構成す

型電極が形成されn型コンタクト層となるGaN層、アンドープの窒化物半導体であるn型GaN層、次に発光層を構成するバリア層となるGaN層、井戸層を構成するInGaN層、バリア層となるGaN層(量子井戸構造)、発光層上にMgがドープされたp型クラッド層としてAIGaN層、Mgがドープされたp型コンタクト層であるGaN層を順次積層させる。エッチングによりサファイア基板上の窒化物半導体に同一面側で、pn各コンタクト層表面を露出させる。各コンタクト層上に、スパッタリング法を用いてAIを蒸着し、正負各電極をそれぞれ形成させる。出来上がった半導体ウエハーをスクライブラインを引いた後、外力により分割させ発光素子を形成させる。

【 O 1 5 6】表面に銀でメッキされた鉄入り銅から構成されるマウントリードのカップ底面上に、ダイボンド樹脂としてエポキシ樹脂組成物を利用して上記発光素子をダイボンドする。これを170℃で75分加熱しエポキシ樹脂組成物を硬化させ発光素子を固定する。次に、発光素子の正負各電極と、マウントリード及びインナーリードとをAu線によりワイヤーボンディングさせ電気的導通を取る。

【 O 1 5 7 】実施例 9 と同様にして調製した組成物を砲弾型の型枠であるキャスティングケース内に注入させる。上記の発光素子がカップ内に配置されたマウントリード及びインナーリードの一部をキャスティングケース内に挿入し 1 O 0 <sup>∞</sup> 1 時間の初期硬化を行う。キャスティングケースから発光ダイオードを抜き出し、窒素雰囲気下において 1 2 0 <sup>∞</sup> 1 時間で硬化を行う。これにより砲弾型等のランプタイプの発光ダイオードを作成することができる。

【0158】(実施例12)実施例11に記載の方法で 組成物および発光素子を作成する。

【0159】エッチングにより一対の釼箔パターンをガラスエポキシ樹脂上に形成させることによって、リード電極を持った基板を形成する。発光索子をエポキシ樹脂

を用いてガラスエポキシ樹脂上にダイボンドする。発光索子の各電極と、各リード電極とをそれぞれA U線でワイヤボンディングし電気的導通を取る。基板上にマスク兼側壁として貫通孔があいたガラスエポキシ樹脂をエポキシ樹脂により固定配置させる。この状態で真空装置内に配置させると共に発光素子が配置されたガラスエポキシ樹脂基板上に組成物をディスペンスし、貫通孔を利用したキャビティ内に組成物を充填する。この状態で、100℃1時間、さらに150℃1時間硬化させる。各発光ダイオードチップごとに分割させることでチップタイプ発光ダイオードを作成することができる。

【O 1 6 O】 (実施例 1 3) 実施例 1 1 に記載の方法で 組成物および発光素子を作成する。

【0161】インサート成形によりPPS樹脂を用いてチップタイプ発光ダイオードのパッケージを形成させる。パッケージ内は、発光素子が配される開口部を備え、銀メッキした銅板を外部電極として配置させる。パッケージ内部で発光素子をエポキシ樹脂を用いてダイボンドして固定する。導電性ワイヤーであるAu線を発光素子の各電極とパッケージに設けられた各外部電極とにそれぞれワイヤーボンディングし電気的に接続させる。パッケージ開口部内にモールド部材として組成物を充填する。この状態で、100℃1時間、さらに150℃1時間硬化させる。この様にして、チップタイプ発光ダイオードを作成することができる。

【0162】(実施例14)実施例11に記載の方法で 組成物および発光索子を作成する。

【 O 1 6 3 】組成物を9 0 ℃ 3 0 分加熱してBステージ 化する。

【O 1 6 4】エッチングにより一対の銅箔パターンをガラスエポキシ樹脂上に形成させることによって、リード電極を持った基板を形成する。発光素子をエポキシ樹脂を用いてガラスエポキシ樹脂上にダイボンドする。発光素子の各電極と、各リード電極とをそれぞれAu線でワイヤボンディングし電気的導通を取る。上記Bステージ化した組成物を用いてトランスファー成形により発光素子およびリード電極の一部を封止する。SMDタイプの発光ダイオードを作成することができる。

【0165】(実施例15)実施例10と同様に順次積層された窒化物半導体において、RIE(反応性イオンエッチング)装置でp型窒化物半導体層側からエッチングを行い、負電極が形成されるn型コンタクト層の表面を露出させる。次に、最上層にあるp型コンタクト層上のほぼ全面にリフトオフ法によりNi/Auを膜厚60/200人にて積層し、オーミック接触が良好で且つ優れた透過性を有する第一の正電極を形成する。また、上記透光性第一の正電極上の一部にAuを膜厚1μm積層し、正極側ボンディング部となる第二の正電極を形成する。

【0166】一方、エッチングにより露出されたn型コ

ンタクト層の表面にそれぞれターゲットを変えてスパッタリングによりW/AI/W/Auを膜厚200Å/2000Å/3000Åとなるよう積層し、不要なレジスト膜を除去させ負電極を形成し、LED素子とする。これにより、アニーリングを行わなくとも良好なオーミック接触を有する負電極が形成される。また、負電極はボンディング部となるが、上記構成により強い機械的強度を有するため、安定して駆動することが可能なLED素子が得られる。

【〇167】次に、パターニングにより、各電極のボンディング部のみを露出させ素子表面全体に接してSiO2からなる絶縁性無機化合物層を連続的に形成し、LED素子とする。上記絶縁性無機化合物層は少なくとも短絡を防止できるように形成されていればよく、上記正電極と上記負電極の間の半導体層上面に設けられていればよい。このように絶縁性無機化合物層を設けることは、小型化された発光素子を信頼性高く実装するにあたり非常に重要である。絶縁性無機化合物層の材料は、少なくとも絶縁性であれば良く、例えばSiO2、TiO2、AI2〇3、Si3N4等からなる単層又は複数層を用いることができる。

【0168】また、本実施例では、上記絶縁性無機化合物層を発光素子の端面まで連続して設けている。これにより、基板の削られた端面及び露出面を高温高湿から保護することができ、厳しい環境条件下での長期間使用に際しても高い信頼性を維持することが可能な発光素子が得られる。また、サファイア基板や窒化ガリウムと直接接して設けられる絶縁性無機化合物層は、それぞれ接する部材と近い熱膨張係数を有することが好ましく、これにより更に信頼性を高めることができる。ちなみに、各材料の熱膨張係数は、サファイア基板が7.5~8.5 ×10<sup>-6</sup>/ $_{\bf k}$ 、窒化ガリウムが3.2~5.6×10<sup>-6</sup>/ $_{\bf k}$ 、窒化シリコンが2.5~3.0×10<sup>-6</sup>/ $_{\bf k}$ である。

【 O 1 6 9】本実施例で使用する発光素子は、発光層で発光された光の多くは上下の層との境界面にて全反射され、発光端部から光密度高く発光する傾向にある。このような発光素子を直接樹脂にて被覆すると、これらに発光素子からの光や熱が集中するため、隣接する樹脂部が局所的に著しく劣化される。これが起因となり、発光イオードに色調変化や信頼性低下が生じると考えられる。そこで本実施例では、絶縁性無機化合物層と比較が高。そこで本実施例では、絶縁性無機化合物層と比較の着性が高い傾向にあり且つ耐光性及び耐熱性に優れた本発明の組成物にて直接被覆することにより、上記発光領域端部から発光される光を効率よく外部へ取り出し、界面における劣化を抑制し、信頼性の高い発光装置を提供する

【0170】また、上記発光端部とは、発光層及びn型

コンタクト層端部を示す。そこで、これらの端部に設けられる絶縁性無機化合物層は、n型コンタクト層としてよく用いられるG a Nよりも屈折率が小さい無機物にて構成することが好ましい。これにより、組成物の劣化を抑制することができる。更に、前記絶縁性無機化合物を、例えば、発光素子の発光端部に直接接する第一の層としてG i G i G 2 を i G 2 を i G 2 を i G 2 を i G 2 や、G i G 2 や、G i G 2 や、G i G 2 で i G 3 に i G 4 に i G 5 i G 6 に i G 7 に i G 8 に i G 8 に i G 9 に i G

【0171】また、本実施例のように、発光索子の表面 に無機化合物層を設け、該無機化合物層上に接して本発 明の組成物にて封止材を形成する場合、前記無機化合物 層と前記封止材との光屈折率差、熱膨張係数差、及び各 界面の密着性を考慮し、前記無機化合物層は本発明の組 成物の必須成分(D)の一部である金属原子及び/又は 半金属原子と共通の原子を有することが好ましい。これ により光取り出し効率および信頼性を向上させることが できる。さらに、上記共通原子としてケイ素を選択する と、他の原子を共通原子として選択した場合と比較し て、高温高湿等の環境条件下においても高い信頼性及び 光学特性を維持することができる傾向にある。この理由 は定かでないが、本発明の組成物の必須成分(A)とケ イ索を有する物質とは、何らかの作用により親和性が良 く、これらの界面は密着性が高いと考えられ、これによ り水分や外気の侵入が抑制されているためだと考えられ る。珪素を含有する無機化合物層とは、前記無機化合物 中に少なくとも珪素が含有されていれば特に限定され ず、具体的には、SiO2、SiN、SiON、及びS iH4等からなる無機化合物層が挙げられる。

【0172】上記のように形成されたLED素子を有するウェハをスクライブ可能な基板厚まで研磨工程によって削り、基板面が粘着シートに接触するように粘着シート上に載置し、スクライブ工程によってチップ状に分割する。分割されたLEDチップを実施例13と同様のパッケージ内部に同様の方法にて固定し、Au線によりワイヤーボンディングさせ電気的に接続させる。

【0173】次に、実施例9と同様にして調製された組成物を、上記パッケージ内部に注入する。注入後、100℃1時間+150℃1時間硬化させ封止材とし、チップタイプ発光ダイオードを形成する。

【0174】このようにして形成された発光ダイオードは、優れた耐熱性且つ強靱性を有する封止材にて構成されているため、実装時や点灯時の熱応力による樹脂及び発光素子におけるクラック発生やワイヤ断線を防止することができる。

【O175】また、このようにして得られた封止材には、(D)成分の加水分解縮合反応によって、微粒子の集合体からなる非結晶性金属酸化物及び/又は非結晶性半金属酸化物が分散している。上記微粒子集合体は、高純度で且つ高い透明性を有しているため、光取り出し効率を妨げることなく封止材の線膨脹係数を小さくすることができる。これにより、信頼性向上と光学的性能の維持の両立を実現することが可能な発光ダイオードを得ることができる。

【0176】このように本発明の発光ダイオードは、優れた耐熱性を有しているため、Pbを有していない、高融点値を有する導電部材にて実装しても、色度変動や信頼性低下を生じず、環境に優しい表示装置を実現することができる。

【0177】また、本発明の封止材は、熱応力における 柔軟性を有する硬化物である。従来、熱応力に柔軟性を 有する樹脂として、ゴム状弾性樹脂、ゲル樹脂等が知ら れているが、これらの樹脂は架橋密度が低い又は架橋構 造を有さないので機械的強度が弱く、またタック性を有 するため異物が付着しやすい等の問題点を有しており、 最表面部となる発光面として形成するには不向きであっ た。これに対し本発明の組成物は、異物を付着したり実 装用器具にて損傷を受ける恐れがない。このように本発 明は、本発明の組成物を用いることにより、発光素子及 びワイヤ部分の被覆部材と発光装置の表面部となる発光 面の部材を一体成形することができ、量産性及び作業性 に優れた発光ダイオードを得ることができる。また、太 陽光に対しても優れた耐光性を有するため、屋外用表示 基板に実装されても発光面は変色されず良好な信頼性を 維持することができる。

【0178】本発明では、各構成部材に無機蛍光物質や 有機蛍光物質等、種々の蛍光物質を含有させることが出 来る。このような蛍光物質の一例として、無機蛍光体で ある希土類元素を含有する蛍光体がある。希土類元素含 有蛍光体として、具体的には、Y、Lu、Sc、La、 Gd及びSmの群から選択される少なくとも1つの元素 と、AI、Ga、及びInの群から選択される少なくと も1つの元素とを有するざくろ石型蛍光体が挙げられ る。特にセリウムで付活されたイットリウム・アルミニ ウム酸化物系蛍光体が好ましく、所望に応じてCeに加 えてb、Cu、Ag、Au、Fe、Cr、Nd、Dy、 Ni、Ti、Eu、及びPr等を含有させることも可能 である。また、本発明の組成物に、上記発光素子の光の 一部を吸収し他の波長の光を発光することが可能で且つ 表面に上記組成物と共通な無機元素を含有する物質がコ ーティングされた無機蛍光物質を添加すると、これらの 界面は化学結合等により良好な密着性を有する傾向にあ る。また、上記蛍光物質は上記構成とすることにより上 記組成物中にて良好に分散した状態で固着される。これ により、上記無機蛍光物質の光吸収率及び光取り出し効 率が向上され高輝度で均一に発光することが可能な色変 換型発光ダイオードが得られる。

【 O 1 7 9 】 (実施例 1 6) 実施例 1 3 と同様の方法にて、パッケージ内に発光索子を載置しワイヤにて電気的接続を取る。ここでパッケージの開口部を除く表面にレジスト膜を形成する。このようにLEDチップが載置されたパッケージを純水が入った容器内に配置させる。

【0180】他方、粒子状蛍光体は、Y、Gd、Ceの希土類元素を化学量論比で酸に溶解した溶解液を蓚酸で共沈させる。これを焼成して得られる共沈酸化物と、酸化アルミニウムと混合して混合原料を得る。これにフラックスとしてフッ化アルミニウムを混合して坩堝に詰め、弱還元雰囲気中および還元雰囲気中にて1400℃の温度で3時間焼成して焼成品を得る。焼成品を水中でボールミルして、洗浄、分離、乾燥、最後に飾を通して(YO.8GdO.2)3AI5O12:Ce蛍光体を形成する。こうして得られた蛍光物質をSiO2ゾル中に分散させてなる混合溶液を形成する。

【0181】次に、酢酸でpHを5.0に調整した後、直ちにパッケージが配置された容器中に上記混合溶液を一挙に注入する。静置後(YO.8GdO.2)3AI5O12:Ce蛍光体はパッケージの開口部及び発光素子上に沈降する。容器内の廃液を除去しLEDチップ上に粒子状蛍光体が堆積したパッケージを120℃で乾燥させる。

【0182】次に、容器から発光ダイオードを取り出し

て発光ダイオードの非発光部に付着した粒子状蛍光体をレジストマスクごと除去する。こうして得られた発光ダイオードは、LEDチップ上とパッケージ底面との膜厚が共に約40μmと略等しい無機化合物層を有する。さらに、LEDチップや粒子状蛍光体を外部応力、太陽光、水分及び塵埃などから保護する目的で、無機化合物層が形成されたパッケージ内にモールド部材として実施例9と同様に調製された組成物を充填し封止部材を形成する。

【0183】こうして得られた発光ダイオードは、耐久性に優れ且つ他の部材との線膨張係数差が緩和された封止部材にて構成されているため、厳しい環境下での使用や長時間の使用に際しても色ズレや色むらが生じることなく、優れた信頼性を有している。

【 0 1 8 4 】 (実施例 1 7) ダイボンド樹脂として本発明の組成物を利用する以外は、実施例 1 0 と同様にして発光ダイオードを形成する。このように構成することにより、発光素子の周囲の部材を全て耐熱性及び耐光性に優れた組成物とすることができ、更に信頼性の高い発光ダイオードが得られる。

#### [0185]

【発明の効果】本発明の組成物から製造した材料は、光 劣化が少なく、線膨張係数が小さく、さらに光学的透明 性が高く、かつ、硬質であり表面タック性を有さない光 学材料用に適した材料である。

### フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

HO1L 33/00

(72) 発明者 津村 学

大阪府摂津市鳥飼西5丁目2-23浩然寮A

(72)発明者 坂本 晴美

大阪府摂津市鳥飼和道1丁目8-28サニー コート401号室

(72)発明者 藤田 雅幸

大阪府摂津市鳥飼西5丁目5-32-102

(72) 発明者 蔵本 雅史

德島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化 学工業株式会社内 FΙ

テーマコード(参考)

HO1L 33/00

Ν

(72)発明者 三木 倫英

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化 学工業株式会社内

Fターム(参考) 4J002 BG041 BL011 CC041 CF001

CF161 CG001 CH001 CL001 CM041 DA117 DD078 DE197

EC078 EX006 EX038 EX049

FD157 GP00

5F041 AA34 AA44 CA04 CA05 CA34

CA40 CA46 CA65 DA16 DA19

DA33 DA34 DA45 DA73 DA76

DB01 DB06 DB09